

大見研究室 和文 論文リスト

1994 年

- 528(M) 大見忠弘、「金属表面のCr₂O₃およびNiF₂不動態処理」、表面技術 Vol.45、No.1、((社)表面技術協会)、pp.26-31、1994年 1月。
- 529(M) 大見忠弘、「巻頭言 第2段階に入ったマイクロエレクトロニクス革命」、ブレイクスルー、No.91、((株)リアライズ社)、pp.8-12、1994年 1月。
- 526-2(M) 大見忠弘、柴田直、「しなやかな情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクス」、ブレイクスルー、No.91、((株)リアライズ社)、pp.21-30、1994年 1月。
- 530(P) 大見忠弘、安井信一、「超純水へのオゾンの利用」、クリーンテクノロジー、Vol.4、No.2、(日本工業出版(株))、pp.54-61、1994年 2月。
- 404-2(P) 大見忠弘、「静電気障害とその完全な制御を目指して」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-5、1994年 2月。
- 531(P) 稲葉仁、大見忠弘、吉田隆紀、岡田孝夫、「ガス分子イオン化による帯電防止技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.16-22、1994年 2月。
- 406-2(P) 須藤誠司、大見忠弘、三島博之、「表面帯電電荷量計測技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.23-28、1994年 2月。
- 532(B) 大見忠弘、「(5章 電子波エレクトロニクス、5-2 超LSIデバイスの限界と展望)5-2-4 しなやかな知的情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクス」、難波進編、メゾスコピック現象の基礎、(オーム社)、pp.253-263、1994年 2月。
- 533(M) 大見忠弘、「パラダイムシフトの時代を迎えたマイクロエレクトロニクス」、三菱電機技報、Vol.68、No.3、(三菱電機技報社)、pp.2、1994年 3月。
- 534(M) 大見忠弘、柴田直、「インテリジェントデバイス—4端子デバイスの概念としなやかな情報処理システムへの応用」、インテリジェント材料、Vol.4、No.1、((社)未踏科学技術協会 インテリジェント材料フォーラム)、pp.16-30、1994年 3月。
- 535(M) 大見忠弘、柴田直、「しなやかな情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクス—21世紀への提言」、電子工業月報 第36巻 第4号(通巻378号)、((社)日本電子工業振興協会)、pp.9-21、1994年 4月。
- 536(P) 大見忠弘、「半導体工場の超純水、回収水、処理水、薬液供給、精製回収および再利用技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-7、1994年 4月。
- 417-2(P) 去来川辰彦、木暮雅彦、大見忠弘、「シリコンウェハ表面への有機物の吸着とオゾン添加超純水による除去」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.14-18、1994年 4月。
- 419-2(P) 大谷克秀、井原清彦、大見忠弘、「PFA表面における金属不純物の吸着脱離」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.42-46、1994年 4月。
- 537(P) 三木正博、前野又五郎、福留敏郎、大見忠弘、「フッ素薬液回収技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.52-57、1994年 4月。
- 538(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.21 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(2)、1994年 4月。
- 539(P) 大見忠弘、「UCT最新研究動向」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.31-45、1994年 4月。

- 540(P) 河合泰明、小西信博、渡辺仁三、大見忠弘、「低エネルギーイオンを用いた低温ゲート酸化膜形成技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.105-112、1994年4月。
- 541(P) 北林徹夫、宮地淳、小原淳、粕川敦彦、大見忠弘、「半導体製造装置内でのシリコンウェハ用静電チャックの吸着メカニズム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.176-182、1994年4月。
- 542(P) T.Suenaga, N.Yonekawa and T.Ohmi「Consideration for the Sustenance of Surface Cleanliness while Wafer Transportation」超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.265-271、1994年4月。
- 543(P) 都田昌之、宍戸昌広、山谷秀一、酒井諒一、梅田優、菅野洋一、大見忠弘、「TEOSの熱分解特性」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.341-351、1994年4月。
- 544(P) 川田幸司、鈴木浩、前田祐二、大見忠弘、「WF6のSi、SiO₂表面上における熱分解」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.352-365、1994年4月。
- 545(P) 白井泰雪、小嶋努、高橋慎治、三好伸二、檜崎勝貴、大見忠弘、「特殊材料ガス用酸化クロムステンレス配管システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 21、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.366-375、1994年4月。
- 546(P) 森永均、陶山誠、能勢昌之、大見忠弘、「ウェットプロセスにおける金属不純物のSi表面への付着メカニズムと付着防止技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.11、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-8、pp.47-54、1994年4月。
- 547(P) 米川直道、安井信一、大見忠弘、「有機物汚染のないシリコンウェハ表面洗浄技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.11、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-9、pp.55-62、1994年4月。
- 548(P) 柴田直、Rita Au、山下毅雄、大見忠弘、「ニューロンMOSを用いた多値インテリジェントメモリ」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.19、集積回路、((社)電子情報通信学会)、論文番号 CPSY94-14、FTS94-14、ICD94-14、pp.1-8、1994年4月。
- 549(P) S.Verhaverbeke, R.Messoussi、二ツ木高志、大見忠弘、「The Formation of Terraces and Steps on Si(100) Surfaces and the Change of these Surfaces during WetProcessing」、電子情報通信学会技術研究報告、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-10、pp.63-70、1994年4月。
- 550(P) 大見忠弘、「フラッシュメモリ対応高信頼性極薄酸化膜形成技術」、結晶加工と評価技術第145委員会第65回研究会資料、(日本学術振興会)、pp.36-43、1994年5月。
- 551(M) 平山昌樹、大見忠弘、「プラズマの高精度計測」、ブレイクスルー、No.95、(株)アライズ社)、pp.18-21、1994年5月。
- 552(M) 大見忠弘、「科学技術立国－真価を問われるわが国の研究開発体制－」、ブレイクスルー、No.96、(株)アライズ社)、pp.11-17、1994年6月。
- 553(M) 森永均、大見忠弘、「ウェット洗浄最前線－極微量金属汚染・除去の化学－」、ブレイクスルー、No.96、(株)アライズ社)、pp.34-38、1994年6月。
- 554(P) 丁剛洙、小西信博、柴田直、大見忠弘、「ウルトラクリーンプラズマプロセスによる高品質薄膜形成技術」、日本真空協会1994年6月研究例会“真空と膜質”予稿集、(日本真空協会)、pp.13-39、1994年6月。
- 431-2(P) 大見忠弘、「－巻頭言－健全な繁栄を継続するための半導体技術序文」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-4、1994年6月。
- 433-2(P) 名取巖、市川明宏、大見忠弘、「プロセスチャンバの In-situ クリーニング技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.12-16、1994年6月。

- 434-2(P) 前野又五郎、高橋慎二、泉浩人、大見忠弘、「Cr₂O₃およびNiF₂による金属表面処理技術」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.17-22、1994年6月。
- 435-2(P) 小西信博、柴田直、大見忠弘、「半導体製造装置用ガス排気系の設計論」、ウルトラクリーンテクノロジーVol.6、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.23-29、1994年6月。
- 555(P) 大見忠弘、「低エネルギーイオン照射・低温高品質薄膜形成技術」、第11回薄膜スクール資料—高度化する機能性薄膜の製法と評価—、(日本学術振興会、薄膜第131委員会)、pp.27-41、1994年7月。
- 556(P) 大見忠弘、「21世紀の半導体量産技術」、第22回薄膜・表面物理セミナー、((社)応用物理学会)、pp.1-25、1994年7月。
- 557(M) 中田明良、大見忠弘、「金属汚染低減イオン注入技術」、ブレイクスルー、No.97、(株)リアライズ社)、pp.20-22、1994年7月。
- 558(P) 大見忠弘、「高品質極薄酸化膜形成技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.180、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-37、pp.21-28、1994年7月。
- 559(P) 岡マウリシオ正純、中田明良、富田和朗、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「450℃アニールによる低逆バイアス電流n+p接合の形成」、電子情報通信学科技術研究報告書、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-50、pp.35-41、1994年7月。
- 560(P) 竹脇利至、山田尚、柴田直、大見忠弘、新田雄久、「パルス電流ストレスによるジャイアントグレイン銅配線の信頼性評価」、電子情報通信学会技術研究報告、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-56、pp.79-84、1994年7月。
- 561(P) 鈴木浩、丁剛洙、平山昌樹、大見忠弘、「電流駆動シリサイデーションを用いたアンチフューズ技術」、電子情報通信学会技術研究報告書、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-68、pp.69-72、1994年7月。
- 562(M) 柴田直、大見忠弘、「なぜクリーン表面が必要か」、VMCジャーナル、No.14、(真空冶金株)、pp.9-14、1994年7月。
- 563(M) 大見忠弘、「TFT液晶の製造には超クリーン化技術の導入が不可避であると提唱」、日経マイクロデバイス1994年8月号、No.110、(日経BP社)、pp.87、1994年8月。
- 564(M) 大見忠弘、「次世代情報処理の実現目指す大学間プロジェクトがスタート—超クリーン化技術を基にシリコンで挑戦—」、日経マイクロデバイス1994年8月号、No.110、(日経BP社)、pp.97-102、1994年8月。
- 565(M) 大見忠弘、小嶋努、白井泰雪、「ガス供給系の高性能化・標準化と半導体工場のコスト低減」、セミコンダクターアニュアル〈ガス供給編〉ガスメディア臨時増刊—、((有)ガスメディア社)、pp.16-28、1994年8月。
- 566(P) 小島泉里、能勢昌之、久保和樹、藪本周邦、大見忠弘、「カーボン汚染フリー表面クリーニング及びウェハ搬送技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.193、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-71、pp.15-21、1994年8月。
- 567(P) 泉浩人、三好伸二、大見忠弘、「極微量表面吸着水分の精密計測技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.193、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-73、pp.31-38、1994年8月。
- 568(P) 小西信博、柴田直、大見忠弘、「高性能減圧プロセス用真空排気システムの最適設計」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.193、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-74、pp.39-44、1994年8月。
- 569(P) 鈴江孝司、松浦孝、室田淳一、澤田康次、大見忠弘、「自己制限型原子層エッチングのSi面方位依存性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.194、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-77、pp.7-13、1994年8月。

- 570(P) 渡辺仁三、河合泰明、小西信博、大見忠弘、「低エネルギー・イオンアシスト酸化による超低温ゲート酸化膜形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.194、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-82、pp.45-50、1994年8月。
- 571(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.22 序文ー計測・評価・分析技術こそ学問・技術・産業の基盤であるー」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No. 22、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.(1)-(2)、1994年8月。
- 572(P) 大見忠弘、「21世紀のキーテクノロジー“四端子デバイスマイクロエレクトロニクス”」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 22、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.43-52、1994年8月。
- 573(P) 大見忠弘、米川直道、安井信一、澤本勲、「電解オゾンによるオゾン添加超純水製造と半導体への利用」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 22、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.229-240、1994年8月。
- 574(P) 平山昌樹、大見忠弘、「高周波プラズマ計測技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 22、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.243-251、1994年8月。
- 575(P) 米川直道、安井信一、小島泉里、大見忠弘、「FT-IRによるシリコンウェハ表面有機物測定」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 22、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.307-316、1994年8月。
- 576(P) 藪本周邦、小峰行雄、国井泰夫、大見忠弘、小島泉里、久保和樹、「TDSによるウェハ表面有機物の分析」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 22、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.317-329、1994年8月。
- 577(M) 大見忠弘、「超クリーンがプロセスに革新、TFTアレイ工程の半減もー同一温度でCVD実現、薄膜化も可能にー」、日経マイクロデバイス 1994年9月号、No.111、(日経BP社)、pp.39-44、1994年9月。
- 495-4(M) 大見忠弘、「超LSI製造におけるウルトラクリーン技術と膜分離技術の役割」、MRC News 食品膜技術懇談会誌、No.13、(食品膜技術懇談会)、pp.105-110、1994年9月。
- 578(P) 中井努、柴田直、大見忠弘、「大容量負荷高速駆動用CMOSソースフォロワ・バッファ回路の解析」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94、No.233、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM94-100、pp.61-67、1994年9月。
- 579(M) 大見和幸、藪根辰弘、大見忠弘、「原子オーダー平坦度と酸化膜」、ブレイクスルー、No.98-99、(株リアライズ社)、pp.26-30、1994年9月。
- 580(P) 大見忠弘、「パワーデバイス高性能化を加速する低温化プロセス」、電気学会研究会資料、電子デバイス・半導体電力変換合同研究会、((社)電気学会)、論文番号 EDD-94-34 SPC-94-56、pp.43-52、1994年9月。
- 581-1(M) 大見忠弘、「巻頭言 SORリソグラフィに主要半導体産業の総力結集を」、ブレイクスルー、No.100、(株リアライズ社)、pp.6-9、1994年10月。
- 581-2(P) 白井泰雪、三好伸二、小嶋努、檜崎勝貴、米華克典、大見忠弘、「超精密溶接技術」、第6回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株長野計器製作所)、1994年10月。
- 582-1(P) Osamu Uchizawa, Yohichi Kanno, Kouichi Murakami, Fumiyuki Seino, Takasi Onodera, Tadahiro Ohmi、「CONTROL OF VALVE OPERATING TIME FOR ACCURATE PROCESS CONTROL」、第6回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株長野計器製作所)、1994年10月。
- 582-2(M) 大見忠弘、柴田直、「(第1章)半導体の技術開発」、半導体製造の技術開発、(日本規格協会)、pp.1-18、1994年10月。
- 583(M) 大見忠弘、「低エネルギーイオン注入法」、応用物理、Vol.63、No.11、((社)応用物理学会)、pp.1151-1152、1994年11月。
- 584(M) 大見忠弘、「本質的な価値を生ずるところに集中投資する勇気」、Electronic Journal、第8号、(株電子ジャーナル)、pp.13、1994年11月。

- 585(M) 渡辺仁三、大見忠弘、「プラズマイオン・アシストによるゲート酸化膜の超低温形成技術」、ブレークスルー、No.101、(株リアライズ社)、pp.30-32、1994年11月。
- 586(P) 大見忠弘、新田雄久、「超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.23 序文」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 23、プロシーディング、第1分冊、(半導体基盤技術研究会)、pp.i-ii、1994年11月。
- 587(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーが高性能半導体/液晶製造技術を更に革新する」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 23、プロシーディング、第1分冊、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-14、1994年11月。
- 588(P) 三木正博、福留敏郎、前野又五郎、大見忠弘、「HF、BHF、H3PO4回収技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 23、プロシーディング、第2分冊、(半導体基盤技術研究会)、pp.264-274、1994年11月。
- 589-1(M) 稲葉仁、大見忠弘、吉田隆紀、岡田孝夫、「軟 X 線照射による静電気除去」、高砂熱学工業総合研究所報、No.8、(高砂熱学工業技術本部総合研究所)、pp.27-36、1994年11月。
- 589-2(P) 柴田直、大見忠弘、「センサとニューロンMOSの融合が拓く新しい世界」、第6回画像入力技術シンポジウム、(画像入力技術シンポジウム実行委員会)、pp.21-29、1994年11月。
- 590(W) 大見忠弘、「総括」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.133-147、1993年11月。
- 591(W) 小島泉里、久保和樹、能勢昌之、大見忠弘、「カーボンフリー洗浄技術」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.149-156、1994年11月。
- 592(W) 渡辺仁三、河合泰明、小西信博、関根克行、大見忠弘、「450°Cゲート酸化膜形成技術」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.157-163、1994年11月。
- 593(W) 檜崎勝貴、三好伸二、小嶋努、白井泰雪、米華克典、大見忠弘、「特殊材料ガス用チュービングのステンレス表面処理技術」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.173-180、1994年11月。
- 594(W) 伊野和英、名取巖、市川明宏、Raymond N. Vrtis、大見忠弘、「In situ チャンバクリーニング技術」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.181-188、1994年11月。
- 595(W) 平山昌樹、大見忠弘、「高周波放電プラズマの高精度計測技術」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.189-196、1994年11月。
- 596(W) 鈴木浩、平山昌樹、丁剛洙、大見忠弘、「電流駆動シリサイド化反応を用いた超高速プログラマブルアンチヒューズ」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.205-212、1994年11月。
- 597(W) 大見忠弘、柴田直、「しなやかな情報処理を可能にする4端子デバイスエレクトロニクスー21世紀への提言」、第4回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.213-225、1994年11月。
- 598(P) 大見忠弘、「一巻頭言ーウルトラクリーンテクノロジーの新たな展開」、ウルトラクリーンテクノロジー、(半導体基盤技術研究会)、Vol.6、No5/6、pp.3-6、1994年12月。
- 599(P) 川田幸司、鈴木浩、前田祐二、大見忠弘、「WF6のSi、SiO2表面上における熱分解」、第11回UCTカレッジXI資料集、(半導体基盤技術研究会)、1994年12月。
- 600(P) 白井泰雪、三好伸二、檜崎勝貴、大見忠弘、「半導体製造ドライプロセス用酸化クロムステンレス配管システム」、第11回UCTカレッジXI資料集、(半導体基盤技術研究会)、1994年12月。
- 601(M) 柴田直、大見忠弘、「四端子デバイス・ニューロンMOSFETで実現する知的情報処理電子システム」、ブレークスルー、No.102、(株リアライズ社)、pp.22-26、1994年12月。
- 602(M) 大見和幸、大見忠弘、「Scientific Semiconductor Manufacturing No. 7 還元競合酸化プロセス」、ブレークスルー、No.102、(株リアライズ社)、pp.31-34、1994年12月。

- 603(M) 安井信一、大見忠弘、「最新のウエット洗浄プロセスによるシリコンウエハ表面からの有機物除去」、神鋼パンテック技報、Vol.38、No.3、(神鋼パンテック(株)技術開発本部)、pp.1-5、1994 年 12 月。